

PIN 结 Si 光电二极管

描述

工作在低频区域的 Si 光电二极管,可探测波长处于峰值波长附近的光信号。

应用

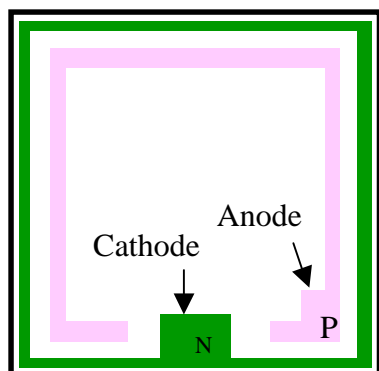
- 遥控电路
- 光纤通信

结构

芯片结构: 平面 PIN 型结构

电极: 顶部 AlSi

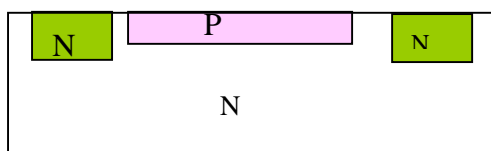
外形图和尺寸



芯片尺寸: 1.0 mm × 1.0 mm

芯片厚度: 300±25μm

纵向结构



芯片结构: 平面 PIN 型结构

电极: AlSi

光电特性 (Ta=25°)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
暗电流 Reverse dark current	I_D	$V_R=10V$ $E=0mW/cm^2$			10	nA
反向击穿电压 Reverse breakdown voltage	V_{BR}	$I_R=100\mu A$, $H=0mV/cm^2$	60	100		V
开路电压 Open circuit voltage	V_{OC}	$E=5mW/cm^2$		400		mV
短路电流 Short circuit current	I_{OC}	$E=5mW/cm^2$		20		μA
光电流 Reverse light current	I_L	$V_R=5V$ $E=5mW/cm^2$		20		μA
总电容 Total capacitance	C_T	$V_R=5V$ $E=0mW/cm^2$ $f=1MHz$		7		pF

典型曲线

- 光谱响应

